

電気学会研究会資料目次

電子材料研究会

〔委員長〕羽路伸夫（横浜国立大学）

〔幹事〕岡田至崇（筑波大学），西川宏之（芝浦工業大学）

日時 平成18年6月28日（水）13:30～16:50

場所 東京工業大学 百年記念館（東京都目黒区大岡山2-12-1）

テーマ「誘電体薄膜集積技術」

- EFM-06-1 MO-CVDによるSrBi₂Ta₂O₉薄膜を用いた0.25 μ m級FeRAM用
スタックキャパシタの開発
山野辺智美，一森高示，小澤晋也，高屋浩二
林 孝尚，足利欣哉，小林康孝，長友良樹（沖電気工業）…………… 1
- EFM-06-2 高い駆動能力を有する高信頼HfSiONゲート絶縁膜の作製
井上真雄，水谷斉治，林 岳（ルネサステクノロジ）
野村幸司（ルネサスセミコンダクタエンジニアリング）
辻川真平，志賀克哉，土本淳一，藤原啓司，米田昌弘（ルネサステクノロジ）…………… 5
- EFM-06-3 極薄HfSiONゲート絶縁膜の絶縁破壊時間の決定
犬宮誠治，奈良安雄（半導体先端テクノロジーズ）…………… 9
- EFM-06-4 高窒素濃度SiON膜のNBTI特性とその窒素起因の劣化メカニズム
佐久間 究，松下大介，中崎 靖，加藤弘一，村岡浩一，三谷祐一郎（東芝）…………… 15
- EFM-06-5 高誘電体ゲート絶縁膜/Si基板界面改質によるトランジスタ特性と絶縁膜
長期信頼性の改善
佐竹秀喜（半導体MIRAIプロジェクト-ASET・現東芝）
岩本邦彦，高橋正志（半導体MIRAIプロジェクト-ASET）
門島 勝（半導体MIRAIプロジェクト-ASET・現Select）
太田裕之（半導体MIRAIプロジェクト-ASRC・AIST）
小川有人，生田目俊秀（半導体MIRAIプロジェクト-ASET）
鳥海 明（半導体MIRAIプロジェクト-ASRC・AIST・東京大学）…………… 21

EFM-06-6 アモルファス Zr シリケートゲート絶縁膜を用いた Ge p-MOSFET の正孔移動度
鎌田善己, 井野恒弘, 上牟田雄一, 飯島良介, 小山正人, 西山 彰 (東芝) …… 25

EFM-06-7 SNDM による Flash Memory の蓄積電荷の視覚化
本田耕一郎 (富士通研究所)
長 康雄 (東北大学) …… 31

協 賛 誘電体薄膜集積技術調査専門委員会